

2SD1961/2SD1962M 2SD2097/2SD2098

エピタキシャルプレーナ形 NPN シリコン トランジスタ
Epitaxial Planar NPN Silicon Transistor

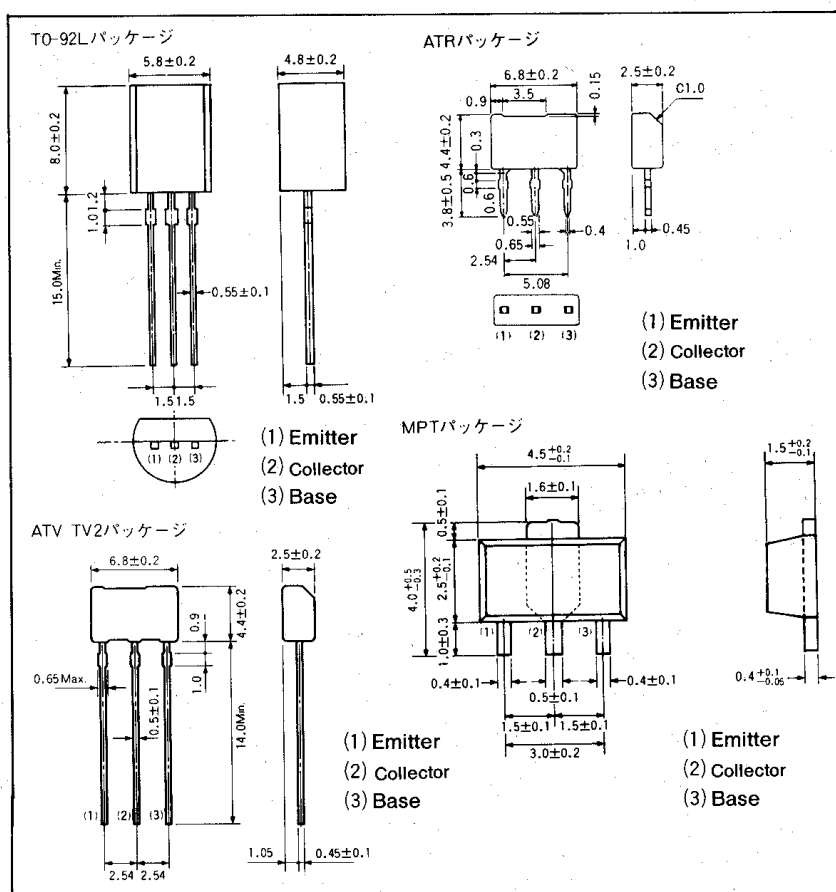
● 特長

- 1) $V_{CE(sat)}$ が低い。
 $V_{CE(sat)}=1V$ (Max.) $I_C/I_B=4A/0.1A$
- 2) 直流電流増幅率 h_{FE} の電流特性が優れている。

● Features

- 1) Low $V_{CE(sat)}$
 $V_{CE(sat)}=1V$ (Max.)
 $I_C/I_B=4A/0.1A$
- 2) Excellent current characteristics of DC current amplification factor h_{FE}

● 外形寸法図/Dimensions (Unit: mm)



● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings ($T_a=25^{\circ}C$)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	50	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	20	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	6	V
コレクタ電流	I_C	5	A
	I_{CP}	10	A (Pulse) *
コレクタ損失	2SD1961	1.2	W (** プリント基板: 厚み 1.6mm のガラスエポ キシ基板の銅箔有効 面積 $1cm^2$ 以上)
	2SD1962M	1.0**	
	2SD2097	1.0**	
	2SD2098	0.5	
接合部温度	T_j	150	$^{\circ}C$
保存温度範囲	T_{stg}	-55~150	$^{\circ}C$

* 10ms 単発パルス

トランジスタ

2SDタイプ